

ESP8266 Flash 读写说明

Version 1.0

Espressif Systems IOT Team Copyright © 2016



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi联盟成员标志归Wi-Fi联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2016 乐鑫信息科技(上海)有限公司所有。保留所有权利。



Table of Contents

1.	前言			
2.	Flash 读写接口			
	2.1.			
	2.2.	spi_flash_write	5	
	2.3.	spi_flash_read	5	
3.	Flash lay	lash layout		
4.	Flash 读写保护示例		7	
	4.1.	问题描述	7	
	4.2.	实现原理	7	
	4.3.	软件示例		
	4.4.	其他建议	8	
	1.	Flash 读写保护参考一	8	
	2.	Flash 读写保护参考二	9	



1. 前言

本文介绍 ESP8266 的 Flash 读写接口,Flash 读写时的注意事项,以及 ESP8266_NONOS_SDK中 IOT_Demo 提供的 Flash 读写保护示例。

2. Flash 读写接口

一个扇区(sector)为 4KB,从扇区 0 开始计数,以下接口可读写整个 Flash 的任意区域:

```
spi flash erase sector : 擦除 Flash 的某个扇区(sector)。
```

spi_flash_write: 将数据写入Flash。spi_flash_read: 读取Flash中的数据。

注意:

- Flash 请先擦再写。
- Flash 读写必须 4 字节对齐。

示例代码:

```
uint32 data[M];

// TODO: fit in the data

spi_flash_erase_sector (N);
spi_flash_write (N*4*1024, data, M*4);
```

返回值:

```
Typedef enum{
         SPI_FLASH_RESULT_OK,
         SPI_FLASH_RESULT_ERR,
         SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT
}SpiFlashOpResult;
```



2.1. spi_flash_erase_sector

功能:	擦除 Flash 的某个扇区。
函数定义:	SpiFlashOpResult spi_flash_erase_sector (uint16 sec)
参数:	uint16 sec - 扇区号,从扇区 0 开始计数,每扇区 4KB
返回值:	SpiFlashOpResult

2.2. spi_flash_write

功能:	将数据写入 Flash。 请先调用 spi_flash_erase_sector 擦除待写区域,再写入数据。	
函数定义:	<pre>SpiFlashOpResult spi_flash_write (uint32 des_addr, uint32 *src_addr, uint32 size)</pre>	
参数:	uint32 des_addr - 写入Flash 的地址,起始位置。 uint32 *src_addr - 写入 Flash 的数据指针。 Uint32 size - 写入数据长度,单位: byte。	
返回值:	SpiFlashOpResult	

2.3. spi_flash_read

功能:	从 Flash 读取数据。
函数定义:	<pre>SpiFlashOpResult spi_flash_read(uint32 src_addr, uint32 * des_addr, uint32 size)</pre>
参数:	uint32 src_addr - 写入Flash 的地址,起始位置。 uint32 *des_addr - 写入 Flash 的数据指针。 Uint32 size - 写入数据长度,单位: byte。
返回值:	SpiFlashOpResult



3. Flash layout

由于上述软件接口,可以读写 Flash 的整个区域,请注意 Flash 以下三个区域划分:

- 程序区:代码编译生成的 bin 文件,烧录到 Flash 占用的区域,请勿改写;
- 系统参数区: esp_iot_sdk 中底层用于存放系统参数的区域,请勿改写;
- 用户参数区:上层应用程序存储用户参数的区域。开发者请根据实际使用的 Flash size 设置,可以参考文档"2A-ESP8266__IOT_SDK_User_Manual" 中的 "Flash Map" 一章。

软件不支持云端升级(none boot)					
7D & C.	eagle.flash.bin	起始于 0x00000 地址			
程序区	eagle.irom0text.bin	起始于 0x40000 地址			
系统参数区	Flash 最后 4 个扇区(B	即 Flash 最后 16 KBytes)			

软件支持云端升级(boot)					
和序员	boot.bin	起始于 0x00000 地址			
程序区	user1.bin	起始于 0x01000 地址			
		12KB Flash Map,则起始于 0x81000 地址; 1024KB Flash Map,起始于 0x101000 地址			
系统参数区	Flash 最后 4 个人	扇区(即 Flash 最后 16 KBytes)			

补充说明:

- 1. 上表程序区仅表明起始位置,占用空间由编译烧录的 bin 大小决定。
- 2. 系统参数区,存储系统级数据:

esp_init_data_default.bin : 位于 Flash 倒数第 4 个 sector blank.bin : 位于 Flash 倒数第 2 个 sector

例如,对于 512KB Flash,

esp_init_data_default.bin 烧到 0x7C000; blank.bin 烧到 0x7E000



4. Flash 读写保护示例

4.1. 问题描述

Flash 擦除的最小单位为一个扇区(4KB),当存储在某个扇区的数据需要改写时,流程是先擦掉整个扇区,再将该扇区的数据写回去。

那么,如果在扇区的擦写过程中突然断电,就有可能导致该扇区的数据丢失。

针对上述问题,Espressif 提供了Flash 读写保护机制的示例,并给出其他读写保护方法的建议。 客户可以直接使用 Espressif 提供的 Flash 读写保护机制,也可以实现自己的 Flash 读写保护机制。

在 ESP8266_NONOS_SDK 的 IOT_Demo 中 user_esp_platform.c 提供了 Flash 读写保护的样例。

4.2. 实现原理

Espressif Flash 读写保护示例,使用三个 sector(扇区)实现(每 sector 4KB),提供 4KB 的可靠存储空间。

将 sector 1 和 sector 2 作为数据 sector,轮流读写,始终分别存放"本次"数据和"前一次"数据,确保了至少有一份数据存储安全; sector 3 作为 flag sector,标志最新的数据存储 sector。

保护机制如下:

- 1. 初始上电时,数据存储在 sector 2 中,从 sector 2 中将数据读到 RAM。
- 2. 第一次写数据时,将数据写入 sector 1。

此时若突然掉电, sector 1写入失败, sector 2 & 3数据未改变; 重新上电时, 仍是从 sector 2 中读取数据, 不影响使用。

3. 改写 sector 3,将标志置为 0,表示数据存于 sector 1。

此时若突然掉电,sector 3 写入失败,sector 1 & 2 均存有一份完整数据; 重新上电时,因 sector 3 无有效 flag, 默认从 sector 2 中读取数据,则仍能正常使用,只是未能包含掉电前对 sector 1 写入的数据。

- 4. 再一次写数据时,先从 sector 3 读取 flag,若 flag 为0,则上次数据存于 sector 1,此次应将数据写入 sector 2;若 flag 为非 0,则认为上次数据存于 sector 2,此次应将数据写入 sector 1。此时若写数据出错,请参考步骤 2、3的说明,同理。
- 5. 写入 sector 1(或 sector 2)完成后,才会写 sector 3,重置 flag。

注意:

只有数据扇区(sector 1或 sector 2)写完之后,才会写 flag sector(sector 3),这样即使 flag sector 写入出错,两个数据扇区都已存有完整数据内容,目前默认会读取 sector 2。

4.3. 软件示例

在 IOT_Demo 中,使用 0x3C000 开始的 4 个 sector(每 sector 4KB),作为用户参数存储区。 其中 0x3D000、0x3E000、0x3F000 这 3 个 sector 实现了读写保护的功能,并存储了应用级参数 esp_platform_saved_param。



如下图:



图中"有读写保护的存储区",IOT_Demo 中建议调用 user_esp_platform_load_param 和 user_esp_platform_save_param 进行读写。

user_esp_platform_load_param - 读 Flash 用户参数区数据 user_esp_platform_save_param - 写 Flash 用户参数区数据

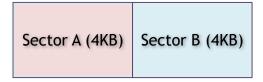
参数 struct esp_platform_saved_param 定义了目前乐鑫存储于 Flash 的用户应用级数据,用户只需将自己要存储的数据添加到结构体 struct esp_platform_saved_param 后面,调用上述两个函数进行 Flash 读写即可。

4.4. 其他建议

1. Flash 读写保护参考一

方法: "轮流写入"+"首部记数"+"尾部校验"

占用空间: 2个 sector, 共计 8KB; 提供 4KB 的带数据保护存储空间。



原理:

仍然采用两个数据 sector 轮流写入来做备份数据保护,只是不再专门设立 flag sector。

记一个 counter,写入数据 sector 的首部,每次写入时计数加一,用记数比较来判别下一次应写入哪个 sector;在数据尾部加入校验码(CRC、checksum 等任一种校验方式),用以验证数据的完整性。

- (1) 假设初次上电,数据存储在 sector A,sector A 的记数为初始值 0xFF,从 sector A 将数据读入 RAM。
- (2) 第一次数据写入 sector B,则在 sector B首部信息中记录 counter 为 1,尾部加入校验码。
- (3) 再次写入数据时,先分别读取 sector A/B 的 counter 值进行比较,此次应当将数据写入 sector A, sector A 首部记录 counter 为 2,尾部加入校验码。

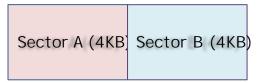
ESP8266 Flash RW Operation

(4) 若发生突然掉电,当前正在写入的 sector 数据丢失,重新上电时,先比较 sector A/B 的 counter 值,读取 counter 值较大的完整 sector,根据 sector 尾部的校验码进行校验,当前 sector 数据是否可靠,若校验通过,则继续执行;若校验失败,则读取另一个 sector 的数据,校验,并执行。

2. Flash 读写保护参考二

方法: "备份扇区"+"尾部校验"

占用空间: 2个 sector, 共计 8KB; 提供 4KB 的带数据保护存储空间。



原理:

始终往 sector A 读写数据,每次写入时,同样写一遍 sector B 作为 sector A 的备份扇区,每个 sector 尾部均加入校验码(CRC、checksum等任一种校验方式)。

- (1) 从 sector A 读取数据,并进行校验。
- (2) 数据写入 sector A, 尾部为校验码。
- (3) sector A 写入完成后,同样的数据也写入 sector B 进行备份。
- (4) 若发生突然掉电,当前正在写入的 sector 数据丢失,重新上电时,先从 sector A 读取数据,根据尾部的校验码进行校验,sector A 数据是否可靠,若校验通过,则继续执行;若校验失败,则读取 sector B 的数据,校验,并执行。